

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB020N04NGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB020N04NGATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 175 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB020N04NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	175 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 95µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	IPB020N04N GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9700pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 140A (Tc) 167W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	140A (Tc)

IPB020N04NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB020N04NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB020N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB020N04NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB020NE7N3 G Infineon Technologies IPB020NE7N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB020N04N INFINEON IPB020N04N INFINEON</p>	 <p>IPB020N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 140A TO263-3</p>	 <p>IPB020N04NG INFINEO IPB020N04NG INFINEO</p>
 <p>IPB019N08N3G INFINEON IPB019N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPB020N10N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A TO263-7</p>	 <p>IPB020N10N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V D2PAK-3</p>	 <p>IPB019N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 180A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB020N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB020N04NGATMA1 Datenblatt	IPB020N04NGATMA1-Datenblätter	IPB020N04NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB020N04NGATMA1
IPB020N04NGATMA1 Electronic	IPB020N04NGATMA1-Komponenten	IPB020N04NGATMA1-Verteiler	IPB020N04NGATMA1-Bild	IPB020N04NGATMA1-Teil
IPB020N04NGATMA1 Preis	IPB020N04NGATMA1 Hersteller	IPB020N04NGATMA1 Bild	IPB020N04NGATMA1 Aktie	IPB020N04NGATMA1 Inventar
IPB020N04NGATMA1 Neu	IPB020N04NGATMA1 Original	IPB020N04NGATMA1 garantiert	IPB020N04NGATMA1 RFQ	IPB020N04NGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited